(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-277540

(P2000-277540A)

(43)公開日 平成12年10月6日(2000.10.6)

(51) Int.CL'		識別記号	ΡI	デーマコート*(参考)
H01L	21/50		HO1L 21/50	A 5F047
	21/52		21/52	F 5F073
H01S	5/042	6 1 0	H 0 1 S 3/18	6 2 4

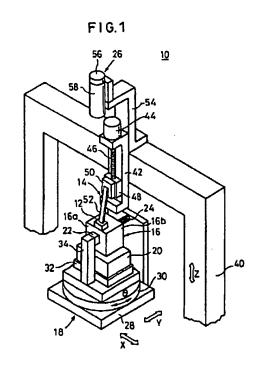
審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

(21)出願番号	特願平11-80408	(71) 出蹟人 000005201
		富士写真フイルム株式会社
(22)出顧日	平成11年3月24日(1999.3.24)	神奈川県南足柄市中沼210番地
		(72)発明者 前田 弘
		神奈川県南足柄市中昭210番地 富士写真
		フイルム株式会社内
		(72)発明者 西田 和弘
		神奈川県南足柄市中福210番地 富士写真
		フイルム株式会社内
		(74)代理人 100077665
		弁理士 千葉 剛宏 (外1名)
		F ターム(参考) 5F047 AA19 CA08 FA14 FA52 FA72
		FA79 FA84
		5P073 DA35 FA23

(54) 【発明の名称】 部品のポンディング装置

(57)【要約】

【課題】装着対象物の熱膨張等に影響されることがなく、この装着対象物上の所定の位置に部品を高精度にボンディングするとともに、構成の簡素化を可能にする。 【解決手段】ヒートシンク16を加熱するヒータ20と、LDチップ12を位置決めするために前記ヒートシンク16に設定された基準端面16aに当接し、前記ヒートシンク16よりも低い熱膨張係数を有する突き当て部材22と、前記ヒートシンク16の端面16bに当接し、該ヒートシンク16を前記突き当て部材22側に加圧するスプリング24とを備える。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】部品を装着対象物上の所定の位置にボンデ ィングするための部品のボンディング装置であって、 前記装着対象物を加熱する加熱手段と、

前記部品を位置決めするために前記装着対象物に設定さ れた基準端面に当接し、前記基準端面を所定の位置に保 持するとともに、該装着対象物よりも低い熱膨張係数を 有する突き当て部材と、

前記装着対象物の前記基準端面と反対側の端面に当接 し、該装着対象物を前記突き当て部材側に加圧する弾性 10 部材と、

を備えることを特徴とする部品のボンディング装置。 【請求項2】請求項1記載のボンディング装置におい て、前記突き当て部材は、前記装着対象物よりも低い熱 伝導率を有することを特徴と する部品のボンディング装

【請求項3】請求項1または2記載のボンディング装置 において、前記突き当て部材が設けられた支持部材と前 記加熱手段との間には、断熱層が介装されることを特徴 とする部品のボンディング装置。

【請求項4】請求項1記載のボンディング装置におい て、前記部品を保持して昇降可能な部品保持手段と、 ボンディング位置の上方から、前記部品と前記装着対象 物とを撮像する撮像手段と、

撮像された前記部品および前記装着対象物の相対位置情 報に基づいて、該部品および該装着対象物を相対的に位 置補正する制御手段と、

を備えることを特徴とする部品のボンディング装置。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、部品を装着対象物 上の所定の位置にボンディングするための部品のボンデ ィング装置に関する。

[0002]

【従来の技術】例えば、半導体レーザ素子(以下、LD という)は、発光中の内部発熱が大きくなり、この熱に よって自己破壊が起こることを阻止するために、一般的 に熱伝導性のよいヒートシンク上にボンディングされた 状態で使用されている。具体的には、図4に示すよう に、LD1は、ヒートシンク 2と、前記ヒートシンク2 上に積層された状態で一体的に結合される半導体レーザ チップ(以下、LDチップという)3とを備えている。 【0003】その際、LDチップ3の発熱を効率よく吸 収しかつ発生したレーザ光を効率的に取り出すために、 LDチップ3とヒートシンク 2の端面同士をずれが発生 しないように、面一にボンディングする必要がある (図 5参照)。ところが、ボンディングは、一般的にろう材 が蒸着されたヒートシンク2をヒータ(加熱手段)で加 熱してLDチップ3と前記ヒートシンク2とをろう付け しているため、ヒートシンク固定部とその周辺部分にヒ 50 て部材から放熟されることを有効に阻止する。このた

ータ熱が伝熱し、この部分に熱変形が発生してしまう。 【0004】これにより、ヒータ加熱前に位置決めされ たLDチップ3とヒートシンク2との相対位置がポンデ ィング中にずれてしまい、放熱性の低下が惹起され、さ

らには、LD1の寿命が短くなるという問題が指摘され ている。また、ヒータ発熱体自体およびヒートシンク2 自体の熱脳張の影響を排除することが不可能であり、こ れらの部分に熱変形が発生して、特に、LDチップ3と ヒートシンク2とのμmオーダの高精度な位置決めが不

【0005】そこで、特開平5-343502号公報に 開示されているように、ヒートシンクとLDチップとを ボンディング前に予め加熱昇温しておき、熱変形が安定 化した後に位置決めしてポンディングを行うダイボンデ

[0006]

可能となるという問題がある。

ィング装置が知られている。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の 従来技術では、ろう材を高温の液体状態で長時間放置す るため、このろう材が酸化し易くなり、接着力が低下す 20 るという不具合が指摘されている。しかも、ろう材が液 体の状態でポンディングを行うため、LDチップの側 面、すなわち、発光面にろう材が付着し易くなり、LD の性能に悪影響を与えるおそれがある。さらに、ヒート シンクおよびLDチップ周辺部材を同一温度に至るまで 加熱する必要があり、加熱に長時間を要するとともに、 多大なヒータ能力が要求されてしまう。

【0007】本発明はこの種の問題を解決するものであ り、部品を装着対象物上の所定の位置に高精度かつ効率 的にポンディングするとともに、構成の簡素化が容易に 30 遂行可能な部品のボンディング装置を提供することを目 的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明に係る部品のポン ディング装置では、装着対象物が加熱手段により加熱さ れる際、突き当て部材がこの装着対象物の基準端面に当 接する一方、前記装着対象物の前記基準面とは反対側の 端面に弾性部材が当接することにより、前記基準端面が 所定の位置に保持される.

【0009】ここで、突き当て部材は、装着対象物より も低い熱膨張係数、例えば、5×10-6以下の材料で形 成されている。従って、突き当て部材は、加熱手段に影 響されることがなく、その突き当て端面を所定の位置に 維持することが可能になり、装着対象物に熱変形が発生 しても該装着対象物の基準端面を所定の位置に確実に保 持することができる。これにより、装着対象物の所望の 位置に部品を高精度に位置決めしてボンディングするこ とが可能になる。

【0010】また、突き当て部材が装着対象物よりも低 い熱伝導率を有しており、装着対象物の熱が前記突き当 3

め、加熱手段に付与されるエネルギを少なくし、エネル ギ効率の向上が容易に図られる。さらに、突き当て部材 が設けられた支持部材と加熱手段との間に断熱層が介装 されており、この支持部材は、前記加熱手段による熱か ら完全に断熱され、基準端面の熱変位の発生が可及的に 阻止される。

[0011]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の実施形態に係る 部品のボンディング装置10の概略斜視説明図であり、 図2は、前記ボンディング装置10の側面説明図であ

【0012】ボンディング装置10は、部品であるLD (レーザダイオード)チップ12を保持して昇降可能な 部品保持手段14と、ヒートシンク16が配置されるX -Y-θステージ18と、前記ヒートシンク16を載置 して加熱する加熱手段であるヒータ20と、前記ヒート シンク16の基準端面16aに当接してこの基準端面1 6 aを所定の位置に保持する突き当て部材22と、前記 ヒートシンク16の前記基準端面16aとは反対側の端 面16 bに当接し、該ヒートシンク16を前記突き当て 20 部材22側に加圧するスプリング(弾性部材)24と、 ボンディング位置の上方から前記しDチップ12と前記 ヒートシンク16とを摄像する撮像手段26と、撮像さ れた前記LDチップ12および前記ヒートシンク16の 相対位置情報に基づいて、該LDチップ12および該ヒ ートシンク16を相対的に位置補正する制御手段27と を備える。

【0013】X-Y-0ステージ18には、図示しないボールねじ等の駆動手段を介してX軸方向およびY軸方向に進退自在な可動台28が設けられ、この可動台28 30上には、Z軸回りに回転自在なのテーブルである回転テーブル30が配置される。回転テーブル30上に支持部材34が配置され、この支持部材34上には、断熱層32を介してヒータ20が装着される。支持部材34の上端部には、突き当て部材22が固着されている。

【0014】突き当て部材22は、ヒートシンク16よりも低い熱膨張係数を有しており、5×10-6以下、好適には、3×10-7以下に設定される。突き当て部材22は、さらに、ヒートシンク16よりも低い熱伝導率を有しており、具体的には、2W/mK以下に設定されて40いる。本実施形態では、突き当て部材22がLiO-A1203ーSiO2系の結晶化ガラスにより構成されており、熱膨張係数が2×10-7で、熱伝導率が2W/mKに設定されている。本実施形態において、断熱層32および支持部材34は、突き当て部材22と同一の材質で構成されている。

い真空発生源に連通する吸引孔38が形成されている (図2参照)

【0016】部品保持手段14は、コラム40に固定されてZ軸方向に延在するフレーム42を備え、このフレーム42の上端部にモータ44が固定される。モータ44の出力軸に連結されてZ軸方向に延在するボールねじ46は、Z軸可動テーブル48に設けられた図示しないナット部材に螺合する。Z軸可動テーブル48に加圧手段50が固定されるとともに、この加圧手段50に保持10部材52が装着される。保持部材52は、中空状を有してその内部が図示しない負圧発生源に連通している。

【0017】 撮像手段26は、コラム40の上部に取付台54を介して装着されており、一あるいは複数のCC Dカメラ56と光学レンズ系58とを備えている。図2に示すように、CCDカメラ56は、画像処理部60に接続されており、この画像処理部60は、前記CCDカメラ56により撮像されたLDチップ12およびヒートシンク16の画像を画像信号として取り込んでそれぞれの位置ずれ量を演算する機能を有する。画像処理部60は、制御手段27に接続されており、この制御手段27は、前記画像処理部60からの演算結果に基づいてX-Y-0ステージ18を駆動して位置補正を行う機能を有する。

【0018】このように構成されるボンディング装置1 0の動作について、以下に説明する。

【0019】先ず、ヒータ20上にヒートシンク16が配置され、このヒータ20に設けられている吸引孔38から吸引を行うことによって、前記ヒートシンク16が前記ヒータ20上に吸着保持される。その際、ヒートシンク16のLDチップ12を位置決めするための基準端面16aが突き当て部材22に当接して位置決めされるとともに、このヒートシンク16の端面16bにスプリング24が当接している。

【0020】一方、部品保持手段14では、保持部材5 2の先端にLDチップ12が吸着保持されており、X-Y-θステージ18が制御手段27を介して駆動され る。このため、ヒートシンク16のボンディング位置が 撮像手段26の光軸上に配置される。次いで、モータ4 4の作用下にボールねじ46を介して2軸可動テーブル 48が下降し、保持部材52に吸着保持されているLD チップ12が下降して所定の高さ位置に配置される。 【0021】ここで、撮像手段26が駆動され、LDチ ップ12およびヒートシンク16が撮像される。撮像手 段26を構成するCCDカメラ56により得られた画像 信号は、画像処理部60に送られて画像処理が施され、 LDチップ12とヒートシンク16との相対位置情報に 基づいてそのずれ量が演算される。このずれ量は、制御 手段27に送られてLDチップ12とヒートシンク16 との相対位置補正が一定の時間間隔毎にリアルタイムで

【0022】例えば、図3に示すように、LDチップ1 2のエッジがヒートシンク16の基準端面16aに対し て補正量 $\Delta \theta$ (>基準値) だけずれていることが検出さ れると、X-Y-Bステージ18に設けられている回転 テーブル30が補正量 $\triangle \theta$ に対応する角度だけ回転し、 ずれ量の補正が行われる。次いで、X軸方向およびY軸 方向のずれ量が基準値よりも大きい場合には、X-Y**θステージ18が駆動制御されてヒートシンク16の基** 準端面16aがLDチップ12のエッジ位置と一致する までフィードバック制御が行われる。

【0023】LDチップ12とヒートシンク16とのず れ量が許容範囲内に入った後、ヒータ20が所定の温 度、本実施形態では、120℃まで昇温される。そし て、モータ44が駆動されて2軸可動テーブル48が下 降し、保持部材52に吸着保持されているLDチップ1 2がヒートシンク16上に当接する。さらに、加圧手段 50を介してLDチップ12をヒートシンク16上に一 定の荷重で加圧保持した状態で、ヒータ20が所定の温 度、本実施形態では、200℃まで昇温される。これに より、ヒートシンク16の上面に予め設けられているろ 20 う材が溶融し、所定時間加熱後に冷却することによって LDチップ12がヒートシンク16上にポンディングさ

【0024】この場合、本実施形態では、LDチップ1 2を位置決めするために、ヒートシンク16に設定され た基準端面16aに、このヒートシンク16よりも低い 熱脳張係数を有する突き当て部材22が当接するととも に、このヒートシンク16の端面16bには、スプリン グ24が当接して前記ヒートシンク16を前記突き当て 動されてヒートシンク16が加熱される際にこのヒート シンク16が熱変形しても、前記ヒートシンク16の基 準端面16aの位置は、突き当て部材22によって確実 に維持される。

【0025】これにより、ヒータ20の加熱前に位置決 めされたLDチップ12とヒートシンク16との相対位 置がボンディング中にずれることがなく、前記LDチッ プ12を所定の位置に高精度にボンディングすることが できるという効果が得られる。特に、LDチップ12と ヒートシンク16との位置決めをμmオーダの高精度で 40 行う際に、ヒータ20自体の熱膨張やヒートシンク16 自体の熱膨張に影響されることがなく、前記LDチップ 12と前記ヒートシンク16との位置ずれの発生を確実 に阻止することが可能になる。

【0026】本実施形態では、突き当て部材22として 熟膨張係数が2×10⁻¹で、熱伝導率が2W/mKのL i O-A 12 O3 - S i O2 系の結晶化ガラスを用いた ところ、LDチップ12とヒートシンク16とのずれ量 が1μm以下となった。一方、突き当て部材22を用い ない場合に、ずれ量が5μm以上となってしまい、この 50 g

突き当て部材22を使用することにより、高精度なポン ディング作業が遂行されるという結果が得られた。

【0027】しかも、本実施形態では、ヒートシンク1 6のろう材を長時間、高温で液体状態に放置することが ないため、このろう材が酸化して接着力が低下すること を阻止するとともに、LDチップ12の側面、すなわ ち、発光面にろう材が付着してLD性能の低下を惹起す ることがない。

【0028】さらにまた、本実施形態では、突き当て部 10 材22の熱伝導率が2W/m K以下に設定されている。 このため、ヒートシンク16が加熱される際にこのヒー トシンク16に接触する突き当て部材22からの放熱量 を有効に減少させることができ、ヒータ20に付与され るエネルギが減少してエネルギ効率が向上するという利 点が得られる。

【0029】また、ヒータ20と支持部材34との間に は、突き当て部材22と同一材質の断熱層32が設けら れている。従って、このヒータ20からの熱が支持部材 34に伝わることを確実に阻止することができ、突き当 て部材22の熱変位を一層確実に低減することが可能に なる.

【0030】なお、本実施形態では、部品としてLDチ ップ12を用い、装着対象物としてヒートシンク16を 用いているが、例えば、部品として半導体チップを用 い、装着対象物として基板を用いても、同様の効果が得 られることになる。また、ヒートシンク16をX-Y-**8ステージ18に配置してこのヒートシンク16をX** 軸、Y軸およびθ軸方向に移動可能に構成しているが、 LDチップ12を吸着保持する加圧手段50にX-Yス 部材22側に加圧している。このため、ヒータ20が駅 30 テージを設ける一方、ヒートシンク16を θ ステージに 装着するように構成してもよい。

[0031]

【発明の効果】本発明に係る部品のボンディング装置で は、加熱手段を介して装着対象物が加熱される際、部品 を位置決めするために前記装着対象物に設定された基準 端面に、低熱膨張係数を有する突き当て部材が当接する ため、前記装着対象物が熱膨張してもその基準端面を所 定の位置に確実に保持し、前記部品を所定の位置に高精 度にボンディングすることができる。特に、構成が有効 - に簡素化されるとともに、装着対象物を長時間加熱状態 で放置することがなく、ろう材の酸化等を有効に阻止し て高精度なポンディング作業が遂行可能になる。

【図面の簡単な説明】

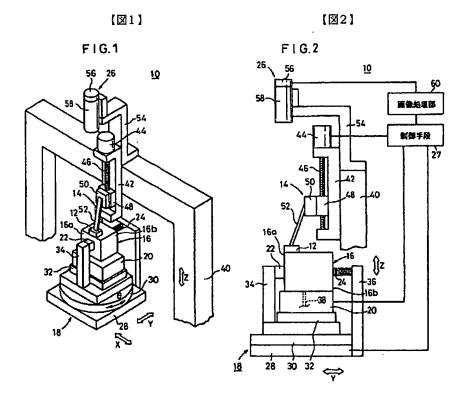
【図1】本発明の実施形態に係る部品のポンディング装 置の概略斜視説明図である。

【図2】前記ボンディング装置の側面説明図である。

【図3】前記ボンディング装置を構成する摄像手段によ る撮像状態の説明図である。

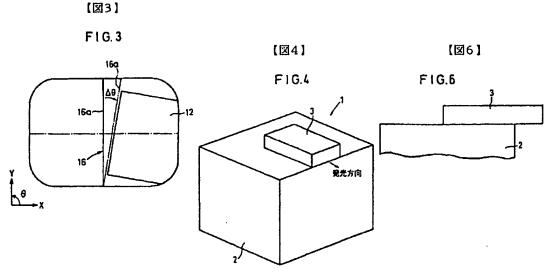
【図4】一般的なLDの斜視説明図である。

【図5】前記LDを構成するLDチップとヒートシンク



22…突き当て部材

18…X-Y-θステージ



【図5】

